

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第4区分
【発行日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【公開番号】特開2004-84040(P2004-84040A)
【公開日】平成16年3月18日(2004.3.18)
【年通号数】公開・登録公報2004-011
【出願番号】特願2002-249796(P2002-249796)
【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 16/44

H 0 1 L 21/205

【F I】

C 2 3 C 16/44 A

H 0 1 L 21/205

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月9日(2005.3.9)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

ガス導入部を備え、内部に被成膜用基体が配置される反応室と、
該反応室の外部より該反応室内の被成膜用基体と前記ガス導入部との間に、前記被成膜用
基体上にホットワイヤーCVD法により第1薄膜を被着するための第1発熱体を搬送する
第1発熱体搬送部材と、を備えた薄膜デバイス用製造装置。

【請求項2】

前記反応室の外部より該反応室内の被成膜用基体と前記ガス導入部との間に、前記第1薄
膜上にホットワイヤーCVD法により第2薄膜を被着するための第2発熱体を搬送する第
2発熱体搬送部材を更に備えた請求項1に記載の薄膜デバイス用製造装置。

【請求項3】

前記第1発熱体の成分と、前記第2発熱体の成分とが互いに異なっていることを特徴とす
る請求項2に記載の薄膜デバイス用製造装置。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3に記載の薄膜デバイス用製造装置を用いて、被成膜用基体上に薄膜
を形成することを特徴とする薄膜デバイスの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0027
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0027】
【課題を解決するための手段】

本発明の薄膜デバイス用製造装置は、ガス導入部を備え、内部に被成膜用基体が配置さ
れる反応室と、該反応室の外部より該反応室内の被成膜用基体と前記ガス導入部との間に
、前記被成膜用基体上にホットワイヤーCVD法により第1薄膜を被着するための第1発
熱体を搬送する第1発熱体搬送部材と、を備えたことを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

本発明の他の薄膜デバイス用製造装置は、上記製造装置において、前記反応室の外部より該反応室内の被成膜用基体と前記ガス導入部との間に、前記第1薄膜上にホットワイヤーCVD法により第2薄膜を被着するための第2発熱体を搬送する第2発熱体搬送部材を更に備えたことを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0029】

本発明の他の薄膜デバイス用製造装置は、上記製造装置において、前記第1発熱体の成分と、前記第2発熱体の成分とが互いに異なっていることを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

本発明の薄膜デバイスの製造方法は、上記製造装置を用いて、被成膜用基体上に薄膜を形成することを特徴とする。

また本発明の他の薄膜デバイスの製造方法は、第1発熱体を用いてホットワイヤーCVD法により被成膜用基体上に第1薄膜を被着する工程と、前記第1発熱体とは異なる第2発熱体を用いてホットワイヤーCVD法により前記第1薄膜上に第2薄膜を被着する工程と、を備えたことを特徴とする。